# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 8月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-251714

[ST. 10/C]:

[JP2002-251714]

出 願
Applicant(s):

人

株式会社デンソー

2003年 7月30日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

TIA2007

【提出日】

平成14年 8月29日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G01N 27/41

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】

黒川 英一

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】

川瀬 友生

【特許出願人】

【識別番号】

000004260

【氏名又は名称】

株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】

100067596

【弁理士】

【氏名又は名称】

伊藤 求馬

【電話番号】

052-683-6066

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

006334

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9105118

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ガスセンサの異常検出装置

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じたガス検出信号を、前記電極と接続された信号線から出力するガスセンサの異常の有無を検出するガスセンサの異常検出装置において、

異常検出対象のセルについて、前記信号線を介して一時的に交流成分を含む試験信号を入力する試験信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記信号線に生じる応答信号を検出する応答信 号検出手段と、

前記応答信号の検出値を規定値と比較して規定値を下回っている場合には、前 記異常検出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめたこと を特徴とするガスセンサの異常検出装置。

【請求項2】 請求項1記載のガスセンサの異常検出装置において、前記応答信号の検出では、前記試験信号に対して所定のタイムディレイを設定したガスセンサの異常検出装置。

【請求項3】 固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じたガス検出信号を、前記電極と接続された信号線から出力するガスセンサであって、複数のセルについて1対の電極の、うち一方の電極が共通のチャンバーに面して設けられる構造のガスセンサを検出対象として、異常の有無を検出するガスセンサの異常検出装置において、

前記複数のセルのうちの所定のセルについて、信号線を介して一時的に交流成 分を含む試験信号を入力する試験信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記複数のセルのうちの前記所定セル以外の異常検出対象のセルに対応する信号線に生じる応答信号を検出する応答信号検出手段と、

前記応答信号の検出値を規定値と比較して規定値を下回っている場合には、異常を出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめたことを特

徴とするガスセンサの異常検出装置。

【請求項4】 請求項3記載のガスセンサの異常検出装置において、前記所 定のセルについて、前記試験信号入力に応答して、前記所定セルに対応する信号 線に生じる応答信号を検出する別の応答信号検出手段と、

前記応答信号の検出値を規定値と比較して規定値を下回っている場合には、前 記所定セルについて断線異常と判ずる別の判定手段とを具備せしめたガスセンサ の異常検出装置。

【請求項5】 請求項4記載のガスセンサの異常検出装置において、前記所 定のセルについて、前記試験信号入力に応答して、前記所定セルに対応する信号 線に生じる応答信号を検出する応答信号検出手段と、

前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記所定セルの電極間のインピーダンスを求めるインピーダンス算出手段と、

得られたインピーダンスに基づいて、前記セルとともに前記ガスセンサに一体に設けられたヒータを制御するヒータ制御手段とを具備せしめたガスセンサの異常検出装置。

【請求項6】 請求項1ないし5いずれか記載のガスセンサの異常検出装置において、前記固体電解質材の温度状態を検出する温度状態検出手段と、

前記温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで、前記判定手段の異常 常判定処理を禁止する禁止手段とを具備せしめたガスセンサの異常検出装置。

【請求項7】 請求項6記載のガスセンサの異常検出装置において、前記温度状態検出手段は、前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記電極間のインピーダンスを求め、前記温度状態は、前記インピーダンスをパラメータとするガスセンサの異常検出装置。

【請求項8】 固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じたガス検出信号を、前記電極と接続された信号線から出力するガスセンサの異常の有無を検出するガスセンサの異常検出装置において、

異常検出対象のセルについて、前記信号線を介して一時的に交流成分を含む試験信号を入力する試験信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記信号線に生じる応答信号を検出する応答信 号検出手段と、

前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記電極間のインピーダンスを求め るインピーダンス算出手段と、

前記インピーダンスの算出値を規定値と比較して規定値を上回っている場合に は、前記異常検出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめ たことを特徴とするガスセンサの異常検出装置。

【請求項9】 請求項8記載のガスセンサの異常検出装置において、前記固 体電解質材の温度状態を検出する温度状態検出手段と、

前記温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで、前記判定手段の異 常判定処理を禁止する禁止手段とを具備せしめたガスセンサの異常検出装置。

【請求項10】 請求項9記載のガスセンサの異常検出装置において、前記 温度状態検出手段は、前記セルとともに前記ガスセンサに一体に設けられたヒー 夕の通電時間を求め、前記温度状態は、前記通電時間をパラメータとするガスセ ンサの異常検出装置。

【請求項11】 請求項9記載のガスセンサの異常検出装置において、前記 温度状態検出手段は、前記セルとともに前記ガスセンサに一体に設けられたヒー 夕の総投入電力量を求め、前記温度状態は、前記総投入電力量をパラメータとす るガスセンサの異常検出装置。

【請求項12】 請求項1ないし11いずれか記載のガスセンサの異常検出 装置において、

前記試験信号入力手段は、前記セルの電源を構成して、前記試験信号として、 一時的な電圧変化若しくは電流変化を前記信号線に入力し、

前記応答信号検出手段は、前記応答信号として前記信号線を流れる電流変化若 しくは電極間の電圧変化を検出するガスセンサの異常検出装置装置。

【請求項13】 請求項12記載のガスセンサの異常検出装置において、 前記試験信号入力手段は、直前の電圧若しくは電流に対して正側と負側との両 方向に相前後して変化するように設定したガスセンサの異常検出装置。

【請求項14】 請求項12記載のガスセンサの異常検出装置において、

前記試験信号入力手段は、直前の電圧若しくは電流に対して正側若しくは負側 の一方向に変化するように設定したガスセンサの異常検出装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ガスセンサの異常検出装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

ガスセンサは種々の分野で用いられており、例えば、内燃機関の排気管に設けられて、内燃機関本体から排出される排気ガス中の酸素等のガス濃度を検出して、その検出信号を機関本体各部の制御に供するようになっている。

[0003]

内燃機関用のガスセンサは、今日、ジルコニア等の酸素イオン導電性の固体電解質材を用いたものが一般的である。例えば、被測定ガスが存在するガスセンサ外部とガスセンサ内部とで酸素が行き来可能にチャンバーを形成し、固体電解質材に1対の電極を形成したセルによりチャンバー内の酸素を汲み出し又は汲み込む構造のものがある。このものでは、電極間に、電極と接続された信号線を介して電圧を印加して固体電解質材の内部にキャリアとしての酸素イオンを移動させることで、酸素を汲み出し又は汲み込むようになっている。そして、電極間にチャンバー内の酸素濃度に応じた限界電流を流し、前記信号線を流れる電流を検出することで酸素濃度が知られるようにしている。また、このような構成のセルを複数設けて、NOxやCO、HCを検出可能としたものもある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、今日の内燃機関等では、実働状態等において、各種の異常の有無の 自己診断を行うことがなされている。ガスセンサにおいても、セルの電極と信号 線との間や、信号線の途中での断線を検出して、正常なガス濃度の検出が不可能 な状態であることが速やかに知られるようにするのが望ましい。

[0005]

信号線の断線を検出する方法として、セルの電極間に電圧を印加して電流の有 無を検出することが考えられる。

## [0006]

しかしながら、ガスセンサは小型化や多セル化が進んでおり、一体に設けられ るヒータやセルの干渉で、得られた検出電流から必ずしも正確には断線の有無を 検出することができない。

## [0007]

本発明は前記実情に鑑みなされたもので、ガスセンサの断線の有無を正確に検 出することのできるガスセンサの異常検出装置を提供することを目的とする。

#### [0008]

## 【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明では、固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し 、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じた信号を、前記電極と接続さ れた信号線から出力するガスセンサの異常の有無を検出するガスセンサの異常検 出装置において、

異常検出対象のセルについて、前記信号線を介して一時的に交流成分を含む試 験信号を入力する信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記信号線に生じる応答信号を検出する応答信 号検出手段と、

前記応答信号の検出値を規定値と比較して規定値を下回っている場合には、前 記異常検出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめる。

## [0009]

セルの電極は固体電解質材を移動する酸素量を確保すべく平面的な広がりをも っているため、セルの等価回路には比較的大きな寄生容量を有している。この寄 生容量により、電極と接続された信号線に断線がなければ、交流成分に応じた電 流が電極間を流れ、比較的大きな応答信号が発生する。断線していれば、応答信 号の大きさは実質的に 0 である。前記のごとく応答信号は比較的大きな信号とな るため、他のセル等の干渉により定常的に信号線に流れる電流による信号と明確 に区別することができ、判定の確度が高い。

## [0010]

また、応答信号が比較的大きな信号となることで、固体電解質材がある程度昇温してインピーダンスがある程度小さくなっていれば断線検出が可能であり、早期に断線を知ることができる。

## [0011]

請求項2記載の発明では、請求項1の発明の構成において、前記応答信号の検 出では、前記試験信号に対して所定のタイムディレイを設定する。

## [0012]

ガスセンサの小型化、複数セル化のため、複数のセルの電極が同一固体電解質材に形成されている構造等では、検出対象のセルとその他のセルとが近接し、セル間に寄生容量が存在している。このため、一方の電極で断線が生じていても、断線の生じていない電極と前記その他のセルの電極間の寄生容量を介して試験信号に応答して電流が流れる。応答信号の検出で試験信号に対して所定のタイムディレイを設定して、かかる信号線上の信号における、セル間の寄生容量の影響が小さくなった状態で断線検出を行うことで、さらに断線検出の確度を高めることができる。

# [0013]

請求項3記載の発明では、固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じたガス検出信号を、前記電極と接続された信号線から出力するガスセンサであって、複数のセルについて1対の電極のうち一方の電極が共通のチャンバーに面して設けられる構造のガスセンサを検出対象として、異常の有無を検出するガスセンサの異常検出装置において

前記複数のセルのうちの所定のセルについて、信号線を介して一時的に交流成 分を含む試験信号を入力する試験信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記複数のセルのうちの前記所定セル以外の異常検出対象のセルに対応する信号線に生じる応答信号を検出する応答信号検出手段と、

前記応答信号の検出値を規定値と比較して規定値を下回っている場合には、異

常検出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめる。

## [0014]

ガスセンサの小型化、複数セル化のため、複数のセルの電極が同一固体電解質材に形成されている構造等では、検出対象のセルとその他のセルとが近接し、セル間に寄生容量が存在している。この寄生容量により、電極と接続された信号線に断線がなければ、交流成分に応じた電流が電極間を流れ、比較的大きな応答信号が発生する。断線していれば、応答信号の大きさは実質的に 0 である。前記のごとく応答信号は比較的大きな信号となるため、他のセル等の干渉により定常的に信号線に流れる電流による信号と明確に区別することができ、判定の確度が高い。

## $[0\ 0\ 1\ 5]$

また、試験信号の出力期間を長めにとって時間をかけて断線検出を行うことが許容される場合、所定セルについて試験信号を入力すると、その分の酸素汲み出し若しくは汲み込み作用により、所定セルの電極が面しているチャンバーの酸素濃度が変化する。これにより、同じチャンバーに面している検出対象セルの電極に接続された信号線に断線がなければ、酸素濃度変化に応じてガス検出信号に変化が生じ、これが応答信号となる。これにより、断線の有無を検出することができる。応答信号が、実際のチャンバー内の酸素濃度の変化に基因したものであるから、他のセル等の干渉により定常的に信号線に流れる電流による信号と明確に区別することができ、判定の確度が高い。

## [0016]

当該検出対象セルについて試験信号入力手段を設けないので、設計の自由度が 拡大する。

# $[0\ 0\ 1\ 7]$

請求項4記載の発明では、請求項3の発明の構成において、前記所定のセルについて、前記試験信号入力に応答して、前記所定セルに対応する信号線に生じる 応答信号を検出する応答信号検出手段と、

前記応答信号の検出値を基準値と比較して基準値を下回っている場合には、前 記所定セルについて断線異常と判ずる別の判定手段とを具備せしめる。

## [0018]

所定セルの断線異常判定用の試験信号を検出対象セルの断線検出用に兼用する ことができるので、構成を簡略化することができる。

## [0019]

請求項5記載の発明では、請求項4の発明の構成において、前記所定のセルについて、前記試験信号入力に応答して、前記所定セルに対応する信号線に生じる 応答信号を検出する応答信号検出手段と、

前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記所定セルの電極間のインピーダンスを求めるインピーダンス算出手段と、

得られたインピーダンスに基づいて、前記セルとともに前記ガスセンサに一体 に設けられたヒータを制御するヒータ制御手段とを具備せしめる。

## [0020]

ヒータ制御に供されるインピーダンス検出用の試験信号を検出対象セルの断線 検出用に兼用することができるので、構成を簡略化することができる。

## [0021]

請求項6記載の発明では、請求項1ないし5の発明の構成において、前記固体 電解質材の温度状態を検出する温度状態検出手段と、

前記温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで、前記判定手段の異常判定処理を禁止する禁止手段とを具備せしめる。

### [0022]

固体電解質材が冷えている状態では電極間のインピーダンスが高く、前記寄生容量は小さい。かかる状態で断線検出を行っても、十分な大きさの応答信号が得られない。したがって、固体電解質材の温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで異常判定がなされないようにすることで、断線の判定確度を高めることができる。

#### [0023]

請求項7記載の発明では、請求項6の発明の構成において、前記温度状態検出 手段は、前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記電極間のインピーダンス を求め、前記温度状態は、前記インピーダンスをパラメータとする。

## [0024]

固体電解質材は、温度状態を活性温度域に向けて昇温するほど電極間のインピーダンスが小さくなるから、電極間のインピーダンスにより好適に固体電解質材の温度状態を知ることができる。別途、センサ類を設ける必要がないから構成を簡略化することができる。

## [0025]

請求項8記載の発明では、固体電解質材に1対の電極が形成されたセルを有し、前記電極の表面における被測定ガスの組成に応じたガス検出信号を、前記電極と接続された信号線から出力するガスセンサの異常の有無を検出するガスセンサの異常検出装置において、

異常検出対象のセルについて、前記信号線を介して一時的に交流成分を含む試験信号を入力する試験信号入力手段と、

前記試験信号入力に応答して、前記信号線に生じる応答信号を検出する応答信 号検出手段と、

前記試験信号と前記応答信号とに基づいて前記電極間のインピーダンスを求めるインピーダンス算出手段と、

前記インピーダンスの算出値を規定値と比較して規定値を上回っている場合には、前記異常検出対象のセルについて断線異常と判ずる判定手段とを具備せしめる。

### [0026]

セルの電極は固体電解質材を移動する酸素量を確保すべく平面的な広がりをもっているため、セルの等価回路には比較的大きな寄生容量を有している。この寄生容量により、電極と接続された信号線に断線がなければ、交流成分に応じた電流が電極間を流れ、比較的大きな応答信号が発生する。ここで、試験信号としての電圧変化や電流変化に対して、応答信号としての電流変化や電圧変化を得れば、電極間のインピーダンスを求めることができる。信号線が断線していれば、応答信号の大きさは実質的に0であり、形式的に前記インピーダンスは無限大となる。前記のごとく応答信号は比較的大きな信号となるため、他のセル等の干渉により信号線に流れる電流による信号と明確に区別することができ、インピーダン

スも正確に求めることができる。これにより、判定の確度が高い。

## [0027]

請求項9記載の発明では、請求項8の発明の構成において、前記固体電解質材 の温度状態を検出する温度状態検出手段と、

前記温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで、前記判定手段の異常判定処理を禁止する禁止手段とを具備せしめる。

## [0028]

固体電解質材が冷えている状態では電極間のインピーダンスが高く、前記寄生容量は小さい。かかる状態で断線検出を行っても、十分な大きさの応答信号が得られない。したがって、固体電解質材の温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達するまで異常判定がなされないようにすることで、断線の判定確度を高めることができる。

### [0029]

請求項10記載の発明では、請求項9の発明の構成において、前記温度状態検 出手段は、前記セルとともに前記ガスセンサに一体に設けられたヒータの通電時 間を求め、前記温度状態は、前記通電時間をパラメータとする。

#### [0030]

固体電解質材が冷えている状態では電極間のインピーダンスが高い。断線がなくとも、断線との誤判定をするおそれがある。したがって、固体電解質材を加熱するヒータの通電時間が十分経過し、固体電解質材の温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達したとみなせるまで異常判定がなされないようにすることで、断線の判定確度を高めることができる。

#### [0031]

請求項11記載の発明では、請求項9の発明の構成において、前記温度状態検 出手段は、前記セルとともに前記ガスセンサに一体に設けられたヒータの総投入 電力量を求め、前記温度状態は、前記総投入電力量をパラメータとする。

#### [0032]

固体電解質材が冷えている状態では電極間のインピーダンスが高い。断線がなくとも、断線との誤判定をするおそれがある。したがって、固体電解質材を加熱

するヒータの総投入電力量が十分な電力量になり、固体電解質材の温度状態が固体電解質材の所定温度域に到達したとみなせるまで異常判定がなされないように することで、断線の判定確度を高めることができる。

## [0033]

請求項12記載の発明では、請求項1ないし11の発明の構成において、前記 試験信号入力手段は、前記セルの電源を構成して、前記試験信号として、一時的 な電圧変化若しくは電流変化を前記信号線に入力し、

前記応答信号検出手段は、前記応答信号として前記信号線を流れる電流変化若 しくは電極間の電圧変化を検出するように構成する。

#### [0034]

セルの電源の電圧若しくは電流を変化させることで試験信号を発生するので、 別途、信号発生源を設ける必要がなく、構成を簡略化することができる。

#### [0035]

請求項13記載の発明では、請求項12の発明の構成において、前記試験信号 入力手段は、直前の電圧若しくは電流に対して正側と負側との両方向に相前後し て変化するように設定する。

### [0036]

電圧の変化でセルの寄生容量の充電状態が変化しても、反対方向の電圧の変化で速やかに充電状態が元に復するから、セルを含む回路の時定数に応じた自然放電を待つことなく、速やかに正常なガス濃度検出が可能になる。

#### [0037]

請求項14記載の発明では、請求項12の発明の構成において、前記試験信号 入力手段は、直前の電圧若しくは電流に対して正側若しくは負側の一方向に変化 するように設定する。

### [0038]

直前の電圧若しくは電流に対して逆方向に変化させないので簡易である。

#### [0039]

#### 【発明の実施の形態】

図1に本発明のガスセンサの異常検出装置を適用したガス濃度検出装置を示す

。本実施形態は例えば自動車の内燃機関用に適用したものである。

## [0040]

ガスセンサ1は例えばエンジンから排出される排気ガスが流通する排気管に設けられ、車室側に設けられたガスセンサ1の制御回路2と配線用のケーブルにより接続される。制御回路を構成するマイクロコンピュータ28では、ガスセンサ1からの各信号に基づいて排気ガス中の酸素濃度およびNOx 濃度(以下、適宜、ガス濃度という)を演算処理し、その結果を出力する。

## [0041]

ガスセンサ1は図2、図3、図4に示すように、ジルコニア等の酸素イオン導電性の固体電解質材である固体電解質層111,112、アルミナ等の絶縁材料からなる絶縁層113,114、アルミナ等の絶縁材料やジルコニア等の固体電解質材からなる層115等が板厚方向に積層する積層構造を有し、面方向に細長の全体形状が与えられている。固体電解質層111,112で挟まれた絶縁層114は一部が板厚方向に打ち抜かれており、固体電解質層111,112の間に、絞り部103を介して互いに連通する2つのチャンバー101,102が形成される。チャンバー101,102はガスセンサ1の長手方向に配置され、ガスセンサ1の先端側の第1のチャンバー101よりもガスセンサ1の基端側の第2のチャンバー102は2倍程度幅広である。

# [0042]

各固体電解質層 1 1 1, 1 1 2 をそれぞれ挟んでチャンバー 1 0 1, 1 0 2 と 反対側には各固体電解質層 1 1 1, 1 1 2 をダクト壁の一部とする大気ダクト 1 0 4, 1 0 5 がそれぞれ形成されている。各大気ダクト 1 0 4, 1 0 5 はガスセンサ 1 の基端で大気に開放している。第1の大気ダクト 1 0 4 は固体電解質層 1 1 2 を挟んで第1チャンバー 1 0 1 と対向する位置まで伸びており、第2のダクト 1 0 5 は固体電解質層 1 1 1 を挟んで第2チャンバー 1 0 2 と対向する位置まで伸びている。ガスセンサ 1 が内燃機関に適用される場合には、ガスセンサ 1 はこれを保持するホルダ部材等とともに排気管の管壁を貫通して設けられて、大気ダクト 1 0 4, 1 0 5 は排気管外部と連通し、基準酸素濃度の空間となる。

# [0043]

第1のチャンバー101位置で、図2中、上側の固体電解質層111には、これを板厚方向に貫通するピンホール106が形成されており、ピンホール106を介して当該ガスセンサ1の周囲の排気ガスが第1チャンバー101内に導入される。ピンホール106の開口端は多孔質アルミナ等の多孔質拡散層116により覆われており、排気微粒子のチャンバー101内への侵入を防止している。

## [0044]

第1チャンバー101位置で固体電解質層112の上下面には固体電解質層112を挟んで対向する1対の電極121,122が形成されており、固体電解質層112と電極121,122とでポンプセル1aが構成される。ポンプセル1aを構成する電極121,122のうち、チャンバー101に面した電極121はNOxの分解(還元)に不活性なAu-Pt等の貴金属により構成されている。以下、適宜、チャンバー101に面した電極121をチャンバー側ポンプ電極121といい、大気ダクト104に面した電極122を大気側ポンプ電極122という。

## [0045]

第2チャンバー102位置で固体電解質層111の上下面には、大気ダクト105に面した電極125を共通として、固体電解質層112を挟んで対向する2組の1対の電極123,125、電極124,125が形成されている。固体電解質層111と電極123,125とでモニタセル1bが構成される。また、固体電解質層111と電極124,125とでセンサセル1cが構成される。チャンバー102に面した電極123,124のうち、モニタセル1bの電極123がNOxの分解(還元)に不活性なAu-Pt等の貴金属により構成され、センサセル1cの電極124がNOxの分解(還元)に活性なPt等の貴金属により構成される。以下、適宜、モニタセル1bのチャンバー102に面した電極123をチャンバー側モニタ電極123といい、センサセル1cのチャンバー102に面した電極124をチャンバー側センサ電極124という。また、モニタセル1bとセンサセル1cとに共通の大気ダクト105に面した電極125を大気側センサ/モニタ電極125という。

# [0046]

また、固体電解質層 1 1 2 とともに大気ダクト 1 0 4 のダクト壁をなす層 1 1 5 には、P t 等の線パターンが埋設されて、ガスセンサ 1 全体を加熱するヒータ 1 3 としてある。ヒータ 1 3 は通電によりジュール熱を発生する電気式のものである。

## [0047]

ガスセンサ 1 において、ガスセンサ 1 の周囲を流れる排気ガスが多孔質拡散層 116 およびピンホール 106 を通って第 15 チャンバー 10 1 に導入されるが、ポンプセル 16 に大気側ポンプ電極 122 側を正として電極 121 、 122 間に電圧を印加すると、排気ガス中の酸素がチャンバ側ポンプ電極 122 で分解、イオン化して固体電解質層 111 を通り大気ダクト 104 へと排出される。このとき、第 15 チャンバー 101 内への酸素の流入はピンホール 106 と多孔質拡散層 116 の流通抵抗が支配的となっている。ポンプセル 16 の電極 121 、 122 間への印加電圧を限界電流域に設定すればその電流値から排気ガス中の酸素濃度が知られる。チャンバ側ポンプ電極 121 が 122 の分解に不活性であるから 122 の 122 は第 122 に第 122 に 122 に

## [0048]

排気ガスは第1チャンバー101から絞り部103を介して第2チャンバー102へと拡散するから、第2チャンバー102には酸素濃度が低下した排気ガスが存在している。モニタセル1b、センサセル1cに、大気側センサ/モニタ電極125側を正として、電極123,125間および電極124,125間に電圧を印加すると、各セル1b,1cではチャンバー102内の余剰酸素が大気ダクト105へと排出され、限界電流が流れる。ここで、第2チャンバー102に面した電極123,124のうち、チャンバ側センサ電極124のみが $NO_X$ の分解に対して活性であるから、センサセル1cに流れる電流の方がモニタセル1bに流れる電流よりも、チャンバ側センサ電極124において $NO_X$ が分解することで生じる酸素イオンの分、多くなる。モニタセル1bに流れる電流とセンサセル1cに流れる電流との差に基づいて排気ガスの $NO_X$  濃度が得られることになる。

## [0049]

## [0050]

詳細には、ポンプセル1 aの大気ポンプ電極122には基準電圧源211の出力が入力する電圧フォロア用のオペアンプ212から基準電圧Vaが印加され、チャンバ側ポンプ電極121には、マイクロコンピュータ28のD/A1からの指令電圧がローパスフィルタ(以下、適宜、LPFという)231を介して入力するオペアンプ232から電流検出用の抵抗器233を介して、電圧Vbが印加される。電圧Vbおよびオペアンプ232の出力電圧Vdはマイクロコンピュータ28のA/D2、A/D3で取り込まれる。これにより、ポンプセル1aの電極121,122間には電圧(Va-Vb)が印加され(以下、適宜、この印加電圧を、ポンプセル電圧Vpという)、電極121,122間に電流(以下、適宜、ポンプセル電流という)Ipが流れると、これが抵抗器233の電圧降下(Vb-Vd)として検出されることになる。前記LPF231は、例えば抵抗器およびコンデンサからなる一次フィルタとして構成される。離散値をとるマイクロコンピュータ28からの指令電圧の波形がLPF231によりなまされてオペアンプ232に入力する。

## [0051]

モニタセル1b、センサセル1cに対しても同様の検出回路が設けられている。すなわち、モニタセル1b、センサセル1cの共通の電極125には基準電圧・

源221の出力が入力する電圧フォロアのオペアンプ222から基準電圧 Vf が 印加されている。モニタセル1bのチャンバ側モニタ電極123には、マイクロコンピュータ28のD/A0からの指令電圧がLPF241を介して入力するオペアンプ242から電流検出用の抵抗器243を介して、電圧 Vc が印加される。電圧 Vc およびオペアンプ242の出力電圧 Ve はマイクロコンピュータ28のA/D0、A/D1で取り込まれる。これにより、モニタセル1aの電極123、125間には電圧(Vf -Vc)が印加され(以下、適宜、この印加電圧を、モニタセル電圧 Vm という)、電極123、125間に電流(以下、適宜、モタセル電流という)Im が流れると、これが抵抗器243の電圧降下(Vc -Ve) として検出されることになる。

## [0052]

一方、センサセル1 c のチャンバ1 0 2 に面した電極1 2 4 には、マイクロコンピュータ28のD/A 2 からの指令電圧がL PF 2 5 1 を介して入力するオペアンプ252から電流検出用の抵抗器253を介して、電圧 V g が印加される。オペアンプ252の出力電圧 V h、および電圧 V g はマイクロコンピュータ28のA/D4、A/D5を介してC P Uに取り込まれる。これにより、センサセル1 c の電極124,125間には電圧 (Vf - V g) が印加され(以下、適宜、この印加電圧を、センサセル電圧 V s という)、電極124,125間に電流(以下、適宜、センサセル電流という)I s が流れると、これが抵抗器253の電圧降下(V g - V h)として検出されることになる。

## [0053]

F241の時定数は15 $\mu$ sec程度に設定される。マイクロコンピュータ28では、この時のモニタセル電圧Vmの電圧変化およびモニタセル電流Imの電流変化に基づいてインピーダンスが求められる。

## [0054]

なお、モニタセル電流 I m 検出用の抵抗器 2 4 3 と並列に別のモニタセル電流 I m 検出用の抵抗器 2 4 4 が設けられている。抵抗器 2 4 4 はスイッチ 2 4 5 により断接切り換え自在である。スイッチ 2 4 5 はマイクロコンピュータ 2 8 の I / O 1 からの制御信号でオンオフし、オン時にはモニタセル電流 I m 検出用の抵抗器の抵抗値を小さくすることができる。スイッチ 2 4 5 のオンによりモニタセル電流 I m 検出用の抵抗器の抵抗値を小さくするのは、インピーダンスの検出時であるが、これは、濃度検出時に比してモニタセル電流 I m が大きくなるため、インピーダンスの検出時とガス濃度検出時とで電流検出電圧(Vc – Ve) がアンバランスにならないようにしたものである。

## [0055]

次にヒータ13の駆動系について説明する。ヒータ13はバッテリ26から通電されるようになっており、通電はMOSFET272によりオンとオフとに切り換えられるようになっている。MOSFET272のゲートには、マイクロコンピュータ28のI/O0からMOSFETドライバ271を介して駆動信号が入力して、前記オンとオフとを切り換えられる。ヒータ13の通電制御はパルス状に電圧を印加するPWM制御でなされ、駆動電流(駆動電力)の調整が、所定周期内の前記パルスのオン期間の長さ(駆動デューティ)を増減することでなされる。

#### [0056]

次にマイクロコンピュータ28で実行される制御プログラムとともに本ガス濃度検出装置の作動について説明する。先ず、図5、図6のフローチャートにより、ガス濃度を検出する基本的な制御について説明する。

## [0057]

図5はメインルーチンの概要を示すもので、制御回路2の電源オンにより起動する。先ずステップS101では前回のガス濃度の検出時から所定時間Ta が経

過したか否かを判定する。所定時間Ta はガス濃度検出の周期に相当する時間であり、例えば4ms程度に設定される。

## [0058]

ステップS 101が肯定判断されるとステップS 102に進み、ガス濃度の検出処理を実行する。ガス濃度の検出処理では、その時々のポンプセル電流 Ip に応じた指令電圧を設定するとともに、その指令電圧出力時のポンプセル電流 Ip を検出する。指令電圧の設定はマイクロコンピュータ 28 の図示しない ROMに格納された印加電圧マップにしたがって設定される。そして、ポンプセル電流 Ip を酸素濃度に換算する。さらに、その時々のモニタセル電流 Im 、センサセル電流 Is を検出する。そして、モニタセル電流 Im 、センサセル電流 Is を検出する。

## [0059]

続くステップS103では、前回のインピーダンスの検出時から所定時間Tbが経過したか否かを判定する。所定時間Tbはインピーダンス検出の周期に相当する時間であり、例えばエンジン運転状態に応じて128msec、2sec等の時間が選択的に設定される。

## [0060]

ステップS103が肯定判断されるとステップS104に進んでインピーダンスの検出処理を実行し、ステップS105で検出インピーダンスに基づいてヒータ13の通電制御を実行する。

#### $[0\ 0\ 6\ 1]$

インピーダンスの検出処理(ステップS104)は、温度状態検出手段としての処理であり、図6に示すように、ステップS201で、D/A0からの指令電圧を例えば正側にごく短時間(数十~数百 $\mu$ sec)シフトし、モニタセル電圧 Vmを変化させるとともに、ステップS202で、このときのモニタセル電圧Vmの変化 $\Delta Vm$ と、モニタセル電流 Imの変化 $\Delta Im$  とを計測する。なお、ステップS201実行前にI/O1によりインピーダンス検出用に抵抗器 244 が接続される。ステップS203はインピーダンス算出手段としての処理で、計測結果に基づいてインピーダンスを算出する。すなわち、モニタセル電流変化 $\Delta Im$ 

とモニタセル電圧変化  $\Delta$  Vm との比( $\Delta$  Vm  $\Delta$  Im)を算出して、これをインピーダンスとする。モニタセル電圧 Vm の変化はLPF241の作用で波形の立ち上がりと立ち下がりがなまされたものとなり、モニタセル1bのリアクタンス成分の影響でモニタセル電流 Im に過大な尖頭成分が現れるのを防止し、インピーダンスの検出精度を高めている。このインピーダンスは、図7に示すように、固体電解質層111,112の温度状態を示しており、温度が高いほど小さくなる。固体電解質の活性温度域まで上昇すると、良好に酸素イオンが流れることになる。

#### [0062]

ヒータ通電制御(ステップS105)はヒータ制御手段としての処理であり、例えば、検出インピーダンスが目標インピーダンスの75%になるまでは、駆動デューティを100%に固定する固定デューティ制御を実行し、目標インピーダンスの75%を越えると、PI制御を実行し、目標インピーダンスに収束せしめる。

## [0063]

次にガスセンサ1の信号線の断線を検出する制御について説明する。

#### [0064]

〈ポンプセル断線〉

図8、図9はポンプセル1aを検出対象とする断線検出処理を示すもので、ステップS301では前記インピーダンス検出処理(ステップS104)で検出されたインピーダンスZACを予め設定した規定値と比較し、規定値以下か否かを判定する。ステップS301は禁止手段としての処理である。インピーダンスZACが規定値以上で否定判断されるとリターンに抜ける。肯定判断されると、ステップS302に進み、ポンプセル断線検出を実行する。

#### [0065]

ポンプセル断線検出処理(ステップS302)では、先ずステップS401で 断線検出のタイミングか否かを判定する。肯定判断されるとステップS402に 進み、否定判断されるとリターンに抜ける。ステップS401は、マイクロコン ピュータ28の所定の制御周期ごとに肯定判断され、ステップS402以降の処

ページ: 20/

理が実行される。

## [0066]

ステップS402は試験信号入力手段としての処理で、ポンプセル電圧Vpを強制変化する。ごく短時間、LPF231に入力するD/A1の指令電圧を直前の電圧値から正側に電圧をややシフトし、その状態から今度は前記直前電圧値よりも負側に僅かにシフトする。これにより、ポンプセル電圧Vpが直前の電圧値を中心に正負に振れる電圧変化を生じることになる。指令電圧の変化、すなわち、試験信号であるポンプセル電圧Vpの変化は、LPF231の作用で波形の立ち上がりと立ち下がりがなまされたものとなる。

## [0067]

ステップS403は応答信号検出手段としての処理で、ポンプセル電圧Vpの強制変化に応答して流れる応答信号であるポンプセル電流Ipの変化 $\Delta Ip$ をインピーダンス検出処理(ステップS104)の場合と同様に取り込む。

## [0068]

ステップ $S404\sim S408$ は判定手段としての処理で、先ずステップS404では、検出されたポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip を予め設定された規定値と比較し、規定値以下か否かを判定する。肯定判断されると、ステップS405に進み、ポンプセル断線カウンタを「1」インクリメントする。

### [0069]

ステップS404はポンプセルが断線していると肯定判断される。これを以下に説明する。ポンプセル1aには、図10に模式的に示すように、電極間に寄生容量が存在し、ポンプセル1aの等価回路は図11のように表せる。したがって、ポンプセル電圧Vpの強制変化により、ポンプセル1aについて断線がなければ図12に示すように、前記等価回路のインピーダンスに応じた電流変化 $\Delta Ip$ が生じることになる。

#### [0070]

### [0071]

したがって、ポンプセル電流変化 $\Delta$  I p の規定値を、ポンプセル電流変化 $\Delta$  I p が実質的に0であるとみなせる値に設定することで、ポンプセル1 a の断線の有無を判定することができる。

## [0072]

本発明では、ポンプセル電圧Vp をごく短時間に一時的に変化させているので 、その交流成分が、ポンプセル1aの寄生容量で、大きなポンプセル電流変化Δ Ip を生じさせる。一体に設けられた他のセル1b, 1cやヒータ13の干渉や 接地電位の変動等があっても、これらに基因した電流変化は、ポンプセル電流I p のレベルを緩やかに変動させる程度のものである。ポンプセル電圧Vp の強制 変化に応答した電流変化  $\Delta$  Ip に比べれば僅少である。したがって、単に電流の 有無をみるだけのものに比して、正確にポンプセル1aの断線の有無を判定する ことができる。また、このため、ポンプセル1aの寄生容量が十分なポンプセル 電流変化ΔIp を生じさせるレベルに達すれば、固体電解質層111, 112が 活性温度に到達するのを待たずに断線検出を行い得る。したがって、前記ステッ プS301におけるインピーダンスの規定値は必ずしも活性温度域に対応するイ ンピーダンス値に設定する必要はなく、活性温度域に対応するインピーダンス値 より高めに設定すればよい。また、ポンプセル電圧Vp の変化による交流成分を 利用するため、LPF231および後述するモニタセル1bの断線検出における LPF241はスパイク性のノイズを除去して波形整形し、検出したい周波数の インピーダンスを考慮してカットオフ周波数を設定することになる。

## [0073]

ポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip が規定値以下で、ポンプセル断線カウンタがカウントアップされると(ステップS404,S405)、ステップS406でポンプセル断線カウンタのカウント値を予め設定した規定値と比較して、規定値に達しているか否かを判定し、否定判断されると、リターンに抜ける。肯定判断されると、ステップS407でポンプセル1aが断線した旨を確定させる。例えば、ポンプセル断線を示すフラグをセットしリターンに抜ける。これにより、燃料噴射制御等の他の制御において、ガスセンサ1に異常が生じたことが知られることになる。ポンプセル断線カウンタの規定値は、例えば数回に設定され、ポンプセル

断線の判定の確度を高めている。

## [0074]

なお、ポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip が規定値以上でステップS 4 0 4 が否定判断されると、ステップS 4 0 8 でポンプセル断線カウンタをクリアしリターンに抜ける。したがって、ポンプセル断線カウンタのカウント値は、ポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip が規定値以下となる結果(ステップS 4 0 4)が連続して現出した場合にのみカウントアップし、突発的にポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip が規定値以下となることがあっても、これをポンプセル断線と誤判定することが回避される。

#### [0075]

また、ポンプセル断線検出処理(ステップS302)はインピーダンスが規定値を下回ったときにのみ実行されるようにしている。すなわち、図14に示すように、固体電解質層111,112の温度が低いと、インピーダンスが高く、前記寄生容量も小さいから、ポンプセル電圧Vp の強制変化に対して十分な大きさのポンプセル電流変化 $\Delta$  Ip が得られず、断線時との差が明瞭ではない。また、S/Nが十分ではない場合がある。そこで、ポンプセル断線検出処理(ステップS302)をインピーダンスが規定値を下回ったときにのみ実行されるようにすることで、ポンプセル断線の判定確度を高めている。

#### [0076]

また、ポンプセル電圧Vp の強制変化(ステップS402)では電圧変化の時間をごく短時間に設定するのがよい。図15がごく短時間に設定した場合のポンプセル電圧Vp、ポンプセル電流Ip、モニタセル電流Im、センサセル電流Is で、図16が電圧変化の時間を長めにとったものである。長めにとると、ガス濃度検出処理(ステップS102)のように、ポンプセル電流Ip に応じてポンプセル電圧Vp を調整したときのように、ポンプセル電圧Vp が静的に変化する傾向が現れる。このため、チャンバー101, 102内の酸素濃度が変化し、モニタセル電流Im、センサセル電流Is が変動して、 $NO_x$  濃度の検出精度に影響する。これに対して、ポンプセル電圧Vp の強制変化をごく短時間のうちに行えば、実質的にチャンバー101, 102内の酸素濃度の変化は生じず、 $NO_x$  濃度の検出精度に影響することはない。

## [0077]

ここで、ポンプセル電圧Vp の強制変化に対して酸素濃度に変化が現れる応答時間はピンホール106 と多孔質拡散層116 の流通抵抗等に依存し、これらを考慮して、ポンプセル電圧Vp の強制変化の時間を設定するのがよい。

## [0078]

また、本実施形態では、ポンプセル電圧 Vp の電圧変化を相前後して正負に切り換えるようにしており、正方向または負方向にのみ変化させる場合に比して、次の効果を有する。すなわち、図17に示すように、正方向または負方向(図例では負方向)にのみ変化させると、その電圧変化に伴ってポンプセル1aの寄生容量に応じて充電された電荷の放電はポンプセル1aを含む回路の時定数に応じたものとなり、放電中は、酸素濃度の検出信号であるポンプセル電流 Ip に誤差が含まれることになる。

## [0079]

これに対して、本実施形態のポンプセル電圧 Vp の電圧変化では、電圧を一方向にシフトすると、電圧変化の直前の電圧値に対して最初にシフトした方向とは逆方向にシフトするようにしているから、最初の電圧シフトに基因した寄生容量の充電が次の逆方向の電圧シフトで速やかに解消され、速やかに正常なガス濃度の検出に復帰することができる。

### [0800]

勿論、ポンプセル電圧 Vp の強制変化が一方向にのみ電圧をシフトするものであるものも、本発明の実施形態として排除するものではなく、要求される仕様によっては、採用することができる。

### [0081]

〈モニタセル断線検出〉

図18、図19は、モニタセル1bを検出対象とする断線検出処理を示すもので、ステップS501ではヒータ13の通電時間(以下、適宜、ヒータ通電時間という)を予め設定した規定値と比較し、規定値以上か否かを判定する。ヒータ通電時間は、ヒータ13の通電開始からの経過時間をカウントする温度状態検出手段であるタイマによりカウントする。ヒータ通電時間が規定値以下で否定判断

されるとリターンに抜ける。肯定判断されると、ステップS502に進み、モニタセル断線検出を実行する。ステップS501は禁止手段としての処理である。

## [0082]

モニタセル断線検出処理(ステップS502)では、ポンプセル断線検出処理(ステップS302)と同様の処理がなされる。先ず、ステップS601で断線検出のタイミングが否かを判定する。肯定判断されるとステップS602に進み、否定判断されるとリターンに抜ける。ステップS601は、ポンプセル断線処理の場合と同様に、マイクロコンピュータ28の所定の制御周期ごとに肯定判断され、ステップS602以降の処理が実行される。

## [0083]

ステップS602は試験信号入力手段としての処理で、モニタセル電圧Vmを強制変化する。その際、I/O1からの制御信号でスイッチ245をオンし、抵抗器244が接続される。ごく短時間、D/A0の指令電圧を直前の電圧値から正側に僅かにシフトし、その状態から今度は前記直前電圧値よりも負側に僅かにシフトする。これにより、モニタセル電圧Vmが直前の電圧値を中心に正負に振れる電圧変化を生じることになる。

## [0084]

ステップS603は応答信号検出手段としての処理で、モニタセル電圧Vmの強制変化に応答して流れるモニタセル電流Imの変化 $\Delta Im$ を取り込む。ここでは、電圧変化開始後、所定の規定時間後のモニタセル電流変化 $\Delta Im$ を検出する。規定時間については後述する。

# [0085]

ステップ $S604\sim S608$ は判定手段としての処理で、先ず、ステップS604では、検出されたモニタセル電流変化 $\Delta$  Im を予め設定された規定値と比較し、規定値以下か否かを判定する。肯定判断されると、ステップS605に進み、モニタセル断線カウンタを「I」、インクリメントする。

# [0086]

ステップS604はモニタセル1bが断線していると肯定判断される。モニタセル1bにはポンプセル1aと同様に電極123,125間に寄生容量が存在す

るが、ポンプセル1aのように単純ではない。すなわち、モニタセル1bは大気ダクト105に面した電極125がセンサセル1cと共通であり、さらに、他方の電極123がセンサセル1cの電極124とともに同じチャンバー102に面して近接して配置されている。このため、モニタセル1bおよびセンサセル1cについて、図20に模式的に示すように、モニタセル1bの電極123,125間の寄生容量CMの他、センサセル1cの電極124,125間の寄生容量CS、および、チャンバー側モニタ電極123とチャンバー側センサ電極124との間の寄生容量(以下、適宜、センサーモニタ寄生容量という)CSMが存在する。したがって、モニタセル電圧Vmの強制変化により、モニタセル1bに断線がなければ図21に示すように、前記寄生容量CM、CS、センサーモニタ寄生容量CSMに応じたモニタセル電流変化ΔImが生じることになる。これは、センサ寄生容量CSおよびセンサーモニタ寄生容量CSMが、モニタ寄生容量CMを増大させるので、その分、モニタセル電流変化ΔImも大きな値が得られる。

## [0087]

一方、モニタセル1 bに断線があれば、チャンバー側モニタ電極123側の信号線で断線が生じていた場合、大気側センサ/モニタ電極125側の信号線で断線が生じていた場合のそれぞれに応じて、図22に示すような挙動が生じる。すなわち、モニタセル電圧VmはD/A0の指令電圧を変化させて、これをLPF241、オペアンプ242、抵抗器243および抵抗器244を介してチャンバー側モニタ電極123に伝送することになるが、チャンバー側モニタ電極123側の信号線が断線の場合は、D/A0の指令電圧を変化させても、モニタセル電流変化ΔImは生じない。この場合には、前記規定値は、モニタセル電流変化ΔImが0とみなせる上限値に設定すればよいことになる。

## [0088]

一方、大気側センサ/モニタ電極  $1 \ 2 \ 5$  側の信号線で断線が生じていた場合には、チャンバー側モニタ電極  $1 \ 2 \ 3$  とチャンバー側センサ電極  $1 \ 2 \ 4$  とが容量結合することで、モニタセル電流変化  $\Delta \ Im$  が生じる。これは、センサーモニタ間寄生容量  $C \ S \ M$ がモニタセル寄生容量  $C \ M$ 等に比して容量が小さいことから、断線のない状態で検出されるモニタセル電流変化  $\Delta \ Im$  よりも小さく、電流変化時

間も短いものとなる。

## [0089]

したがって、前記規定時間のとり方により、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im の規定値が異なる。すなわち、図22のA点やC点でモニタセル電流変化 $\Delta$  Im を求めるとすれば、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im にセンサーモニタ間寄生容量CSMの影響が現れるので、前記上限値よりも大きな値に規定値を設定する必要がある。また、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im にセンサーモニタ間寄生容量CSMの影響が現れないB点でモニタセル電流変化 $\Delta$  Im を求めるとすれば、チャンバ側モニタ電極123断線時と同様、規定値は0とみなせる上限値となる。

#### [0090]

なお、本発明では、モニタセル電圧Vm の強制変化に応答した電流変化 $\Delta Im$  をみているので、ポンプセル1a の断線の場合と同様に、単に電流の有無をみるだけのものに比して、正確にモニタセル1b の断線の有無を判定することができる。

## [0091]

さて、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im が規定値以下で、モニタセル断線カウンタがカウントアップされると(ステップS604,S605)、ステップS606でモニタセル断線カウンタのカウント値を予め設定した規定値と比較して、規定値に達しているか否かを判定し、否定判断されると、リターンに抜ける。肯定判断されると、ステップS607でモニタセル1bが断線した旨を確定させる。この一連の処理は、ポンプセル1aの断線検出処理におけるステップS405~S407と実質的に同じであり、モニタセル断線について、確度の高い判定ができる

## [0092]

なお、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im が規定値以下でステップS604が否定判断されると、ステップS608でモニタセル断線カウンタをクリアしリターンに抜ける。したがって、ポンプセル1aの断線検出処理におけるステップS408と同様に、突発的にモニタセル電流変化 $\Delta$  Im が規定値以下となることがあっても、これをモニタセル1bの断線と誤判定することが回避される。

## [0093]

また、モニタセル断線検出処理(ステップS502)はヒータ通電時間が規定値を越えたときにのみ実行されるようにしている。すなわち、図23に示すように、ヒータ通電時間に応じて固体電解質層111,112の温度が上昇してインピーダンスが低くなり、前記寄生容量CM, CS, CSMも大きくなっていくから、ヒータ通電時間が短い間は寄生容量CM, CS, CSMも小さく、モニタセル電圧Vm の強制変化に対して十分な大きさの電流変化ΔIm が得られず、断線時との差が明瞭ではない。また、S/Nが十分ではない場合がある。そこで、モニタセル断線検出処理(ステップS502)をヒータ通電時間が規定値を越えたときにのみ実行されるようにすることで、モニタセル1bの断線の判定確度を高めている。

## [0094]

なお、本実施形態ではモニタセル断線検出処理(ステップS502)を実行するか否かをヒータ通電時間により判定しているが、正確にはヒータ13に投入された総投入電力量により判定するのがよい。これには、例えば、断線検出タイミングになる(S601)ごとに電力を検出するとともに検出電力を積算して積算値を投入電力量とする。あるいは、電源投入時にヒータ13の電源であるバッテリ26の電圧を検出し、検出電圧に前記ヒータ通電時間を乗じたものにより、固体電解質層111,112の昇温が進んだか否か、すなわちモニタセル断線検出処理(ステップS502)を実行すべき時期か否かを判定するようにしてもよい。これらの他、ヒータ13への投入電力量に応じて単調増加するものであれば、モニタセル断線検出処理(ステップS502)の実行条件となるパラメータとし得る。

## [0095]

また、検出対象であるモニタセル1b以外のセルについて、S201~S203のごときインピーダンス検出処理を実行して固体電解質層111,112の温度状態を検出するものも、本発明の実施形態として排除するものではないが、例えばセンサセル1cについてインピーダンスを検出しようとすると、センサセル電圧を変化させるための回路が、モニタセル1b等のように必要になり、構成は

複雑化し、また、制御負担が大きくなるので、本実施形態のものが実用的である

## [0096]

なお、本実施形態では、モニタセル1bの断線の有無のみを判定しているが、モニタセル1bの電極123,125のうち、いずれの信号線が断線しているか否かを区別することもできる。すなわち、前掲図22において、A点やC点でモニタセル電流変化 $\Delta$  Im をサンプリングすると、断線時のモニタセル電流変化 $\Delta$  Im でも、チャンバー側モニタ電極123が断線したときと、大気側センサ/モニタ電極125が断線したときとで、大きさが異なるから、大小2種類の規定値を設定し、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im が小さい方の規定値以下であれば、チャンバー側モニタ電極123が断線と判じ、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im が小さい方の規定値以上で大きい方の規定値以下であれば、大気側センサ/モニタ電極125が断線と判じるようにする。

## [0097]

なお、図22において、A点とC点とでモニタセル電流変化ΔIm が異なるのは、後のC点の方がモニタセル電圧Vm の電圧変化の幅が大きいためである。

## [0098]

また、モニタセル電流変化 $\Delta$  Im で断線の有無を判じるのではなく、モニタセル電圧変化Vm をモニタセル電流変化 $\Delta$  Im で除したインピーダンスにより、断線の有無を判じてもよい。インピーダンスが規定値以上の場合に、断線と判じることになる。この場合、インピーダンスはインピーダンス検出処理(ステップS 104)のものが用いられ得る。勿論、アドミタンスにより判じてもよい。

#### [0099]

〈センサセル断線検出〉

図24、図25はセンサセル1cを検出対象とする断線検出処理を示すもので、ステップS701では、ポンプセル断線検出の場合(ステップS301)と同様に前記インピーダンス検出処理(ステップS104)で検出されたインピーダンス ZACを予め設定した規定値と比較し、規定値以上であればリターンに抜け、規定値以下であればステップS702に進む。ステップS702では、センサセ

ル電流 Is が規定値以下か否かを判定し、否定判断されるとリターンに抜け、肯定判断されると、ステップS 7 0 3 でセンサセル断線検出を実行する。なお、ステップS 7 0 2 は、センサセル電流 Is が余り大きいと後述する断線検出を実行とした時の電流変化(図 2 6 参照)が、A/D入力のダイナミックレンジを外れてしまうため、かかる状況での断線検出を排除する趣旨である。

## [0100]

センサセル断線検出処理(ステップS703)では、先ず、ステップS801で断線検出のタイミングか否かを判定する。肯定判断されるとステップS802に進み、否定判断されるとリターンに抜ける。ステップS801は、ポンプセル断線検出処理の場合と同様に、マイクロコンピュータ28の所定の制御周期ごとに肯定判断され、ステップS802以降の処理が実行される。

## [0101]

ステップS 8 0 2 は試験信号入力手段としての処理で、モニタセル電圧Vm を強制変化する。これはモニタセル断線検出処理(ステップS 6 0 2)の場合と同様にD/A 0 で指令電圧を変化させることでなされる。

## [0102]

ステップS 8 0 3 は応答信号検出手段としての処理で、モニタセル電圧 Vm の強制変化開始後、所定の規定時間経過後のセンサセル電流変化 Δ Is を検出する。規定時間については後述する。

#### [0103]

### [0104]

ステップS804はセンサセル1cがチャンバー側センサ電極124に対応した信号線で断線していると肯定判断される。センサセル1cとモニタセル1bとは同じチャンバー102に面して電極123,124が設けられているため、モニタセル電圧Vmの強制変化により、チャンバー102内の酸素の汲み出し又は

汲み込み能力が変化すると、これがセンサセル1cに影響する。すなわちチャン バー102内の酸素濃度が変化することで、センサセル1cに断線がなければ、 図26に示すように、直前のセンサセル電流 Is に対して電流変化 $\Delta Is$  が生じる。

## [0105]

一方、センサセル1cに断線があれば、図27に示すように、センサセル電流変化 $\Delta$  Is は生じない。この場合、センサセル1cの大気ダクト105に面した電極125はモニタセル1bと共通であるから、電極125について断線なしと判断されていれば、断線が生じているのは、チャンバ側センサ電極124ということになる。

## [0106]

センサセル電流変化 $\Delta$  Is が規定値以下で、センサセル断線カウンタがカウントアップされると(ステップS 8 0 4 ,S 8 0 5 )、ステップS 8 0 6 でセンサセル断線カウンタのカウント値を予め設定した規定値と比較して、規定値に達しているか否かを判定し、否定判断されると、リターンに抜ける。肯定判断されると、ステップS 8 0 7 でセンサセル 1 c が断線した旨を確定させる。この一連の処理は、ポンプセル 1 a の断線検出処理におけるステップS 4 0 5  $\sim$  S 4 0 7 と実質的に同じであり、センサセル 1 c の断線について、確度の高い判定ができる

# [0107]

なお、センサセル電流変化 $\Delta$  Is が規定値以上でステップS 8 0 4 が否定判断されると、ステップS 8 0 8 でセンサセル断線カウンタをクリアしリターンに抜ける。したがって、センサセル断線カウンタのカウント値は、ポンプセル1 a の断線検出処理におけるステップS 4 0 8 と同様に、突発的にセンサセル電流変化  $\Delta$  Is が規定値以下となることがあっても、これをセンサセル断線と誤判定することが回避される。

# [0108]

また、センサセル断線検出処理(ステップS703)はインピーダンスが規定値を下回ったときを条件としているので、ポンプセル断線検出処理の場合(ステ

ップS301)と同様に、インピーダンスが低く、十分な大きさのセンサセル電流変化 $\Delta$ 1sが得られるときにのみ実行され、センサセル1cの断線の判定確度が高められる。

## [0109]

センサセル1cの断線は、このように検出されるようになっている。センサセル電圧Vsは強制変化させる必要がなく、モニタセル電圧Vmはモニタセル1bの断線検出処理(ステップS502)やインピーダンス検出処理(ステップS104)のときに、ステップS802と同様に強制変化させられる(ステップS602,S201)ので、試験信号入力手段がこれらの処理と兼用となるので、構成が簡単となる。

#### [0110]

なお、モニタセル電圧強制変化の時間が余り長ければチャンバー102内の酸素濃度変化が大きくなり、それだけ大きなセンサセル電流変化 $\Delta$  Is が生じることになるが、酸素濃度が元に復するまでに要する時間 $\Delta$  Tが長くなり、正常なNOx 濃度の検出ができなくなる時間が長引くため、断線の有無を正確に判定し得るセンサセル電流変化 $\Delta$  Is が得られる範囲内で、可及的にモニタセル電圧強制変化の期間の長さは短くとるのが望ましい。

## [0111]

また、モニタセル電圧Vm の電圧変化 $\Delta Vm$  の時間が逆に短い場合でも、モニタセル1 b とセンサセル1 c との間の寄生容量C S M により、図2 6 に示すようにセンサセル電流 I s の電流変化 $\Delta I$  s が生じるので、これを利用して、断線検出を行うのもよい。

#### $[0\ 1\ 1\ 2\ ]$

また、本実施形態では、ポンプセル1a、モニタセル1bのそれぞれの、電流 検出と、電圧変化とを同じ電極121,123側で行っているが、図28に示す ように、電流検出側のオペアンプには基準電圧源を接続し、他方のオペアンプに は電圧変化手段を接続するのもよい。

## [0113]

なお、本実施形態では、ポンプセル電圧 Vp をポンプセル電流 Ip に基づいて

印加電圧マップにしたがって設定する図29に示す制御方式をとっているが、図30に示すように、モニタセル電流 Im に基づいて、モニタセル電流 Im が所定値をとるようにポンプセル電圧 Vp をフィードバック制御するものにも本発明は適用することができる。

## [0114]

また、センサ構造についても図例のものに限られない。図31は本発明を適用 し得るガスセンサの別の例を示すもので、このガスセンサ1Aは、ジルコニア等 の固体電解質材である固体電解質層151,152,153、多孔質アルミナ等 の絶縁材料からなる律速層154、アルミナ等の絶縁材料からなる絶縁層やジル コニア等で構成される層155等が板厚方向に積層する積層構造を有し、面方向 に細長の全体形状が与えられている。

## [0115]

固体電解質層152および律速層154は固体電解質層151と固体電解質層153とで挟まれた同じ層を形成しており、ガスセンサの先端側に律速層154が位置し、基端側に固体電解質層152が位置する。固体電解質層152および律速層154は、一部が板厚方向に打ち抜かれており、固体電解質層151,152の間に、ガスセンサ1Aの長手方向に配置された2つのチャンバー141,142が形成される。律速層154は、ガスセンサの先端側で第1のチャンバー141にガスセンサ1A外部の被測定ガスを導入するとともに、第1のチャンバー141と第2のチャンバー142との境界部で両チャンバー141,142を連通せしめている。

## [0116]

固体電解質層153を挟んでチャンバー141,142と反対側には固体電解質層153をダクト壁の一部とする大気ダクト143が形成されている。大気ダクト143は先端側が固体電解質層153を挟んで第1チャンバー141と対向する位置まで伸び、ガスセンサ1Aの基端で大気に開放している。ガスセンサ1Aが内燃機関に適用される場合には、ガスセンサ1Aがこれを保持するホルダ部材等とともに排気管の管壁を貫通して設けられて、大気ダクト143が排気管外部と連通する。

## [0117]

第1チャンバー141位置で固体電解質層151の上下面には固体電解質層151を挟んで対向する1対の電極161, 162が形成されており、固体電解質層151と電極161, 162とでポンプセル1 dが構成される。ポンプセル1 dを構成する電極161, 162035、チャンバー141に面した電極161は10、の分解(還元)に不活性な1411 等の貴金属により構成されている

## [0118]

また、第1 チャンバー1 4 1 および大気ダクト1 4 3 位置で固体電解質層1 5 3 の上下面には固体電解質層1 5 3 を挟んで対向する1 対の電極1 6 3 , 1 6 5 が形成されており、固体電解質層1 5 3 と電極1 6 3 , 1 6 5 とでモニタセル1 e が構成される。モニタセル1 e を構成する電極1 6 3 , 1 6 5 のうち、チャンバー1 4 1 に面した電極1 6 3 はN  $O_x$  の分解(還元)に不活性なA u -P t 等の貴金属により構成されている。なお、大気ダクト1 4 3 に面した電極1 6 5 は第2 チャンバー1 4 2 位置まで伸びる、電極1 6 3 よりも長い電極であり、後述するセンサセル1 f 、別のポンプセル1 g と共通の電極である。

## [0119]

第2チャンバー142位置で固体電解質層153の上下面には、固体電解質層153を挟んで対向する1対の電極164,165が形成されている。固体電解質層153と電極164,165とでセンサセル1fが構成される。

#### [0120]

また、第2チャンバー142に面して固体電解質層151には、電極166が 形成されており、固体電解質層151~153と電極166,165とで別のポンプセル1gが構成される。この別のポンプセル1gはセンサセル1fと同様に、一方の電極166が第2チャンバー142に面し、他方の電極165が大気ダクト143に面した構造をなっている。

## [0121]

第2チャンバー142に面した電極164,166のうち、センサセル1fの電極164は $NO_X$ の分解(還元)に活性なPt等の貴金属により構成され、別

のポンプセル 1 g の電極 1 6 6 が N  $O_X$  の分解(還元)に不活性 x x y の貴金属により構成される。

## [0122]

また、固体電解質層 153とともに大気ダクト143のダクト壁をなす層 155には、Pt等の線パターンが埋設されて、ガスセンサ1A全体を加熱するヒータ17としてある。ヒータ17は通電によりジュール熱を発生する電気式のものである。

### [0123]

このガスセンサ1Aでは、モニタセル1eで発生する起電圧に基づいて、該起電圧が基準電圧となるように、すなわち、第1チャンバー141内の酸素濃度が一定かつ低濃度となるように、ポンプセル1dの印加電圧がフィードバック制御され、第1チャンバー141内の酸素が排出される。第1チャンバー141と連通する第2チャンバー142内の酸素も同程度に排出される。

## [0124]

そして、第2 チャンバー 1 4 2 内に残った酸素が別のポンプセル 1 g により排出される。センサセル 1 f には、第2 チャンバー 1 4 2 に面した電極 1 6 4 における N  $O_X$  の分解に基因した電流が流れる。この電流は第2 チャンバー 1 4 2 内の N  $O_X$  の濃度に応じたものとなる。

#### [0125]

かかる構造のガスセンサ1Aにおいても、セルの電極間に電圧変化を与えて電極間の寄生容量に応じた電流変化を生じさせることで、セルの断線を他のセル等の影響をうけることなく検出することができる。

#### [0126]

あるいは、図32に示すガスセンサにも適用することができる。ガスセンサ1 Bは、電極の構成以外は図31のものと同じである。電極は、図31の電極16 3を省略した構成となっている。そして、固体電解質層151とこれを挟む電極 161,162とにより第1のポンプセル1dが構成され、固体電解質層151 ~153と電極161,165とにより第1のモニタセル1hが構成される。第 1のモニタセル1hで発生する起電圧に基づいて、該起電圧が基準電圧となるよ うに、すなわち、第1チャンバー141内の酸素濃度が一定かつ低濃度となるように、第1ポンプセル1dの電極161,162間への印加電圧がフィードバック制御され、第1チャンバー141内の酸素が排出される。

# [0127]

また、固体電解質層151とこれを挟む電極166,162とにより第2のポンプセル1iが構成され、固体電解質層151~153と電極166,165とにより第2のモニタセル1jが構成される。第2のモニタセル1jで発生する起電圧に基づいて、該起電圧が基準電圧となるように、すなわち、第2チャンバー142内の酸素濃度が一定かつ低濃度となるように、第2ポンプセル1iの電極166,162間への印加電圧がフィードバック制御され、第2チャンバー142内の酸素が排出される。

# [0128]

固体電解質層153とこれを挟む電極164, 165とによりセンサセル1fが構成され、第2チャンバー142に面した電極164における $NO_X$ の分解に基因した電流が流れる。この電流は第2チャンバー142内の $NO_X$ の濃度に応じたものとなる。

# [0129]

かかる構造のガスセンサ1Bにおいても、セルの電極間に電圧変化を与えて電極間の寄生容量に応じた電流変化を生じさせることで、セルの断線を他のセル等の影響をうけることなく検出することができる。

# [0130]

また、セルの電極間に印加する電圧を変化させているが、信号線に流す電流を 変化させてもよい。

# [0131]

また、断線検出は必ずしも周期的に実行するのではなく、セルが制御不能になった場合や、検出ガス濃度が供される燃料噴射制御等において異常な挙動を呈した場合等に、実行するのでもよい。

# 【図面の簡単な説明】

# 【図1】

本発明のガスセンサの異常検出装置を適用したガス濃度検出装置の構成図である。

#### 【図2】

前記ガスセンサの要部断面図である。

#### 【図3】

図2における I I I - I I I 線に沿う断面図である。

#### 【図4】

図2における IV-IV線に沿う断面図である。

#### 【図5】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガス濃度 検出の制御内容を示す第1のフローチャートである。

#### 【図6】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガス濃度 検出の制御内容を示す第2のフローチャートである。

### 【図7】

前記ガス濃度検出の制御内容を説明するグラフである。

## 【図8】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第1のフローチャートである。

### 図9】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第2のフローチャートである。

#### 【図10】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第1のセルの図である。

#### 【図11】

前記ガスセンサを構成するセルの等価回路図である。

## 【図12】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第1のタイミングチャートである。

# 【図13】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第2のタイミングチャートで ある。

#### 【図14】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第1のグラフである。

## 【図15】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第3のタイミングチャートで ある。

#### 【図16】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第4のタイミングチャートである。

#### 【図17】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第5のタイミングチャートで ある。

### 【図18】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第3のフローチャートである。

#### 【図19】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第4のフローチャートである。

#### 【図20】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第2のセルの図である。

#### 【図21】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第6のタイミングチャートで ある。

## 【図22】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第7のタイミングチャートで ある。

#### 【図23】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第2のグラフである。

# 【図24】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第5のフローチャートである。

### 【図25】

前記ガス濃度検出装置を構成するマイクロコンピュータで実行されるガスセン サの異常検出の制御内容を示す第6のフローチャートである。

## 【図26】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第8のタイミングチャートで ある。

## 【図27】

前記ガスセンサの異常検出の制御内容を説明する第9のタイミングチャートで ある。

### 【図28】

前記ガス濃度検出装置の変形例を示す要部の構成図である。

## 【図29】

図1のガス濃度検出装置におけるガスセンサの断面、および該ガスセンサの制御方式を示す図である。

#### 【図30】

図1のガス濃度検出装置におけるガスセンサの断面、および該ガスセンサの制 御方式の変形例を示す図である。

#### 【図31】

前記ガスセンサの断面の変形例、および該ガスセンサの制御方式を示す図である。

# 【図32】

前記ガスセンサの断面の別の変形例、および該ガスセンサの制御方式を示す図 である。

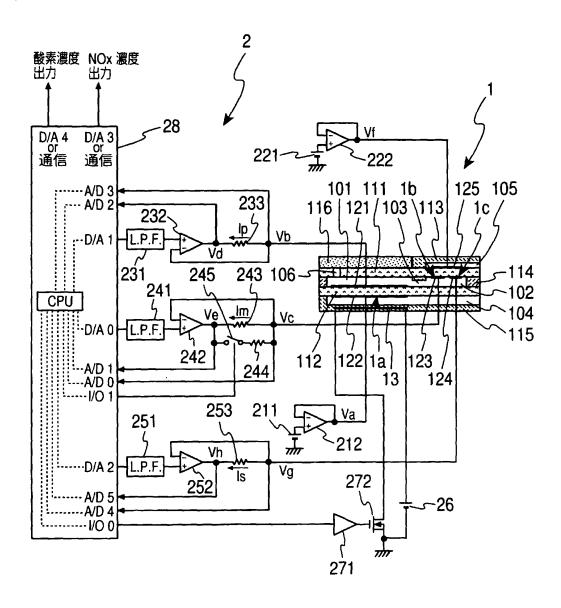
#### 【符号の説明】

1, 1A, 1B ガスセンサ

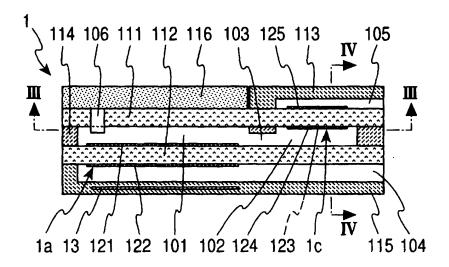
- 1a, 1d, 1g, 1i ポンプセル
- 1 b, 1 h, 1 j モニタセル
- 1c, 1f センサセル
- 13,17 ヒータ
- 101, 102, 104, 105 チャンバー
- 111, 112, 151, 152, 153 固体電解質層(固体電解質材)
- 121, 122, 123, 124, 125, 161, 162, 163, 164
- , 165, 166 電極
- 28 マイクロコンピュータ (試験信号入力手段、応答信号検出手段、判定手段、インピーダンス算出手段、ヒータ制御手段、温度状態検出手段、禁止手段)

【書類名】 図面

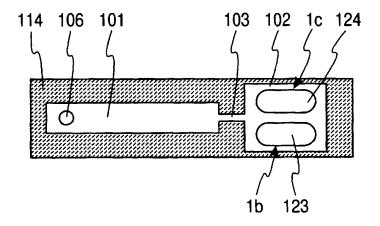
【図1】



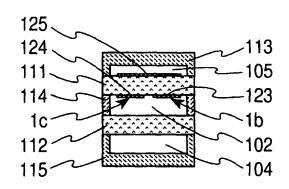
【図2】



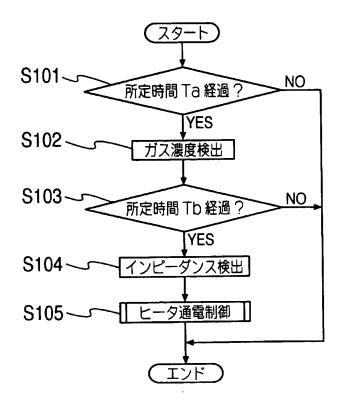
【図3】



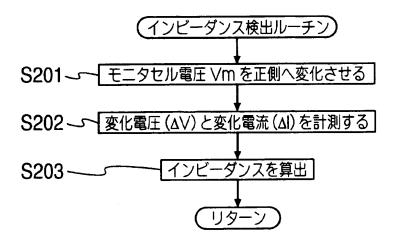
【図4】



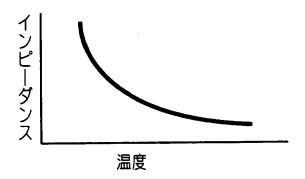
【図5】



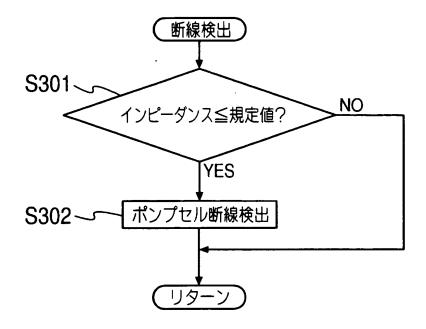
【図6】



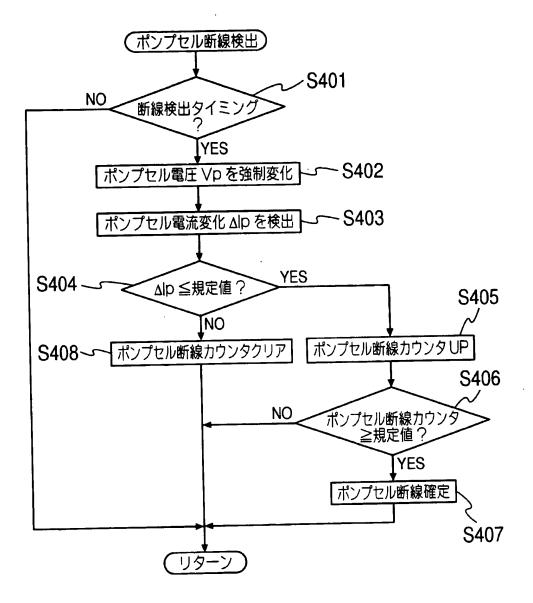
【図7】



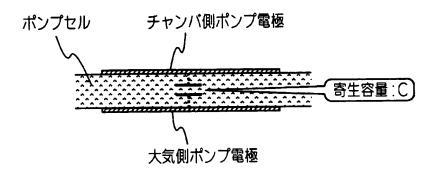
【図8】



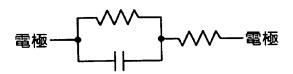
【図9】



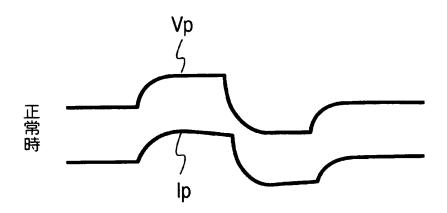
【図10】



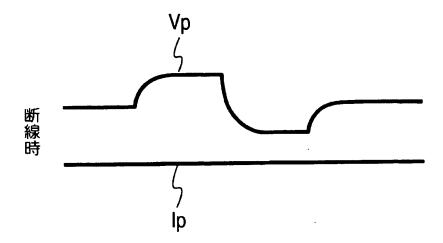
# 【図11】



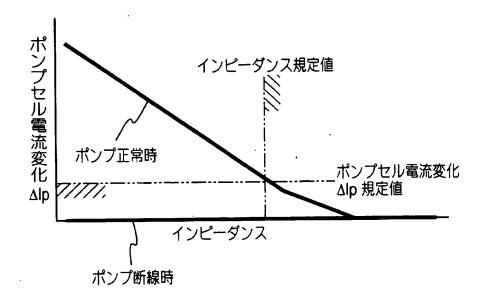
# 【図12】



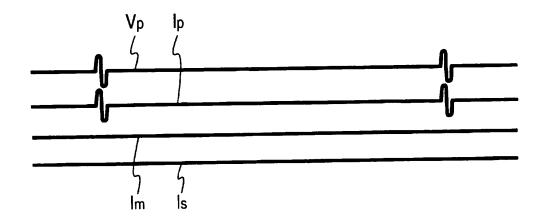
【図13】



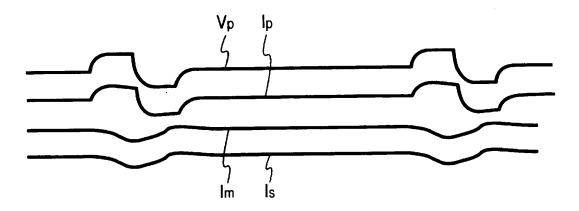
【図14】



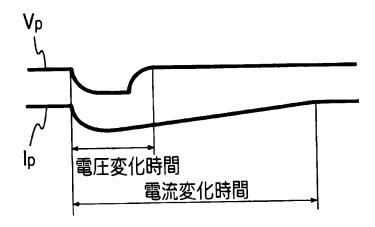
【図15】



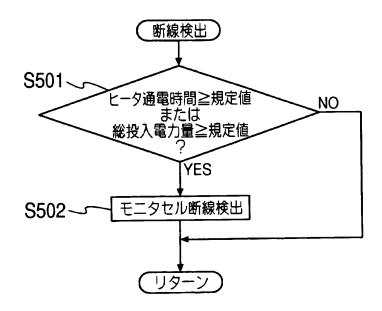
【図16】



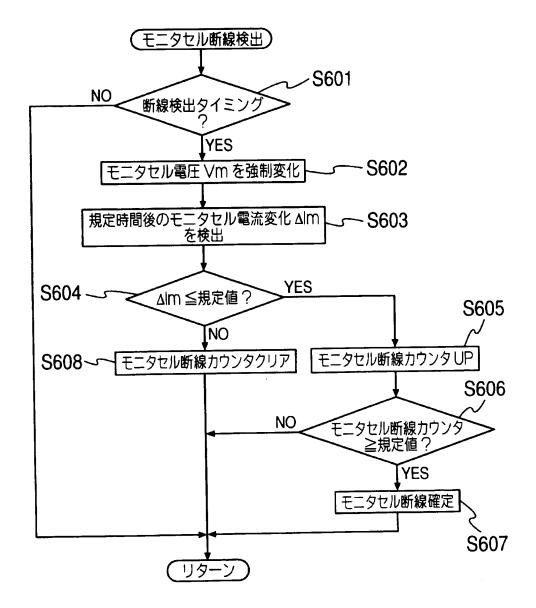
【図17】



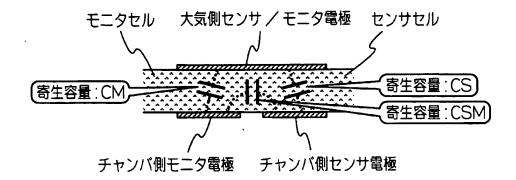
【図18】



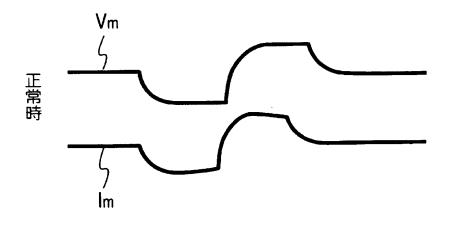
# 【図19】



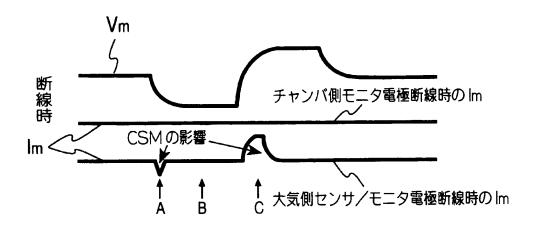
# 【図20】



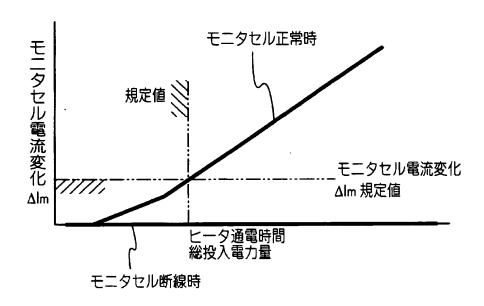
# 【図21】



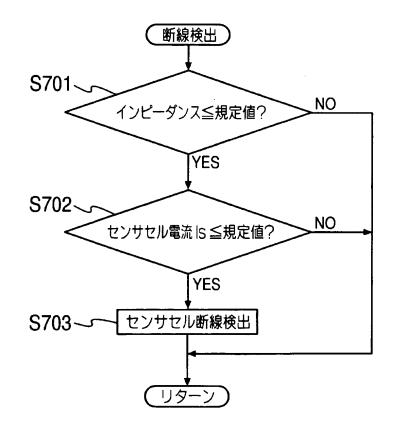
# 【図22】



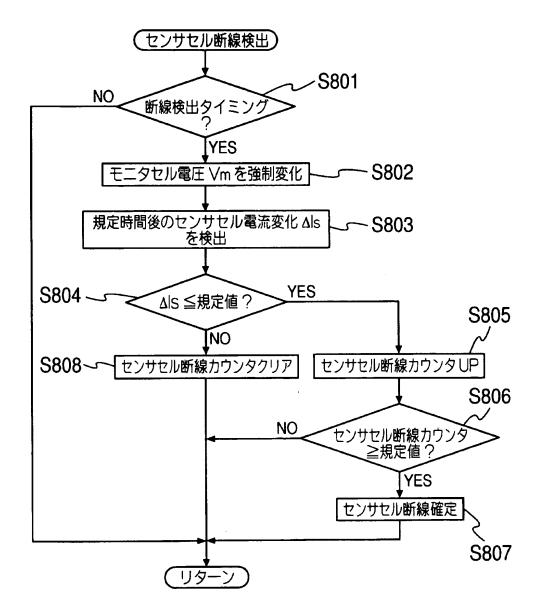
【図23】



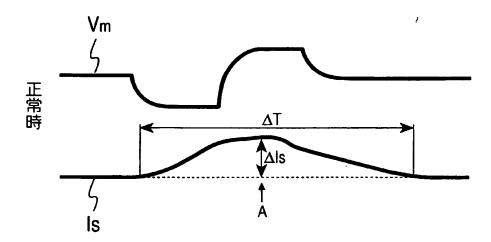
【図24】



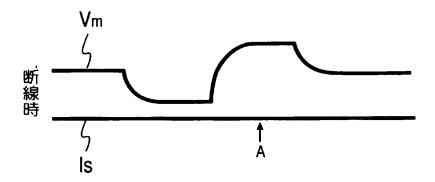
【図25】



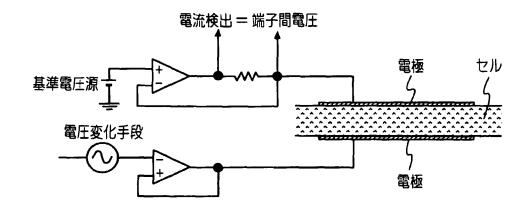
【図26】



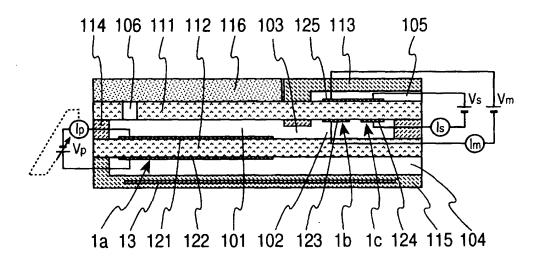
【図27】



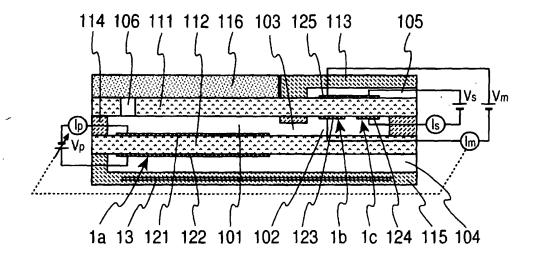
【図28】



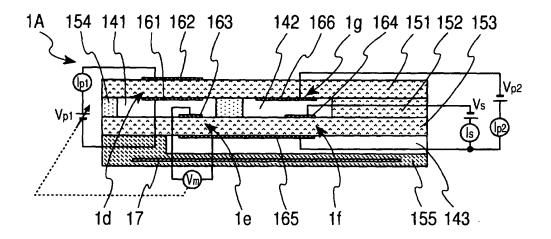
【図29】



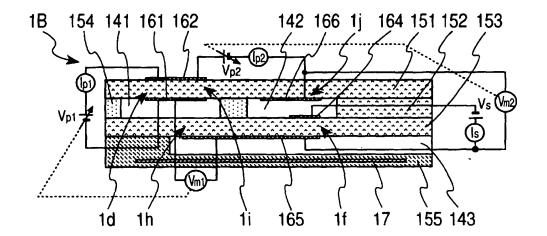
# 【図30】



# 【図31】



【図32】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

ガスセンサの断線を検出することである。 【課題】

【解決手段】 固体電解質材112に1対の電極121、122を形成した検出 対象のセル1aについて、マイクロコンピュータ28が、一時的に交流成分を含 む試験信号を、電極121、122と接続された信号線に入力するとともに、そ の応答信号を検出するようにする。セルlaの寄生容量で、断線がなければ、交 流成分に応じた電流が電極121,122間を流れ、応答信号が発生する。断線 していれば応答信号の大きさは0である。応答信号の検出値が基準値を下回って いる場合には、断線異常と判ずるようにする。一時的に試験信号を入力すること で、その前後におけるガス濃度の検出値の変動を抑制する。セル1 a の寄生容量 で比較的大きな応答信号が得られることで、他のセル1b,1cの干渉を回避す る。

【選択図】 図 1 特願2002-251714

出願人履歴情報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日

1996年10月 8日

[変更理由]

名称変更

住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名

株式会社デンソー